

388383-2026 - Hange

Saksamaa – Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid) – Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaätzanlage)

OJ S 107/2026 05/06/2026

Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Asjad

1. Hankija

1.1. Hankija

Ametlik nimi: Westsächsische Hochschule Zwickau

E-posti aadress: Beschaffungswesen@whz.de

Hankija õiguslik vorm: Piirkondliku omavalitsuse kontrollitav avalik-õiguslik isik

Hankija tegevus: Haridus

2. Menetlus

2.1. Menetlus

Pealkiri: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaätzanlage)

Kirjeldus: Kurze Beschreibung: Anschaffung einer neuen DRIE/ RIE-Anlage

(Plasmaätzanlage) - mit Software- und Anlagensteuerung inklusive Installation und

Einweisung Bestehend aus: DRIE/ RIE-Anlage, Substratelektrode, Kantenschutz der Wafer

während der Ätzung, Notching-Kontrolle/ Reduktion der Strukturabweichung beim Ätzstopp

auf Dielektrika, Endpunktdetektion, Software- und Anlagensteuerung, Verpackung / Transport

/ Abladen / Einbringen / Installation einschließlich Inbetriebnahme und Schulung Beschreibung

der Beschaffung (Art und Umfang der Dienstleistung bzw. Angabe der Bedürfnisse und

Anforderungen) Neue DRIE/ RIE-Anlage inkl. Zubehör für die Forschung an der WHZ mit

folgenden Anforderungen: 01 1 RIE / DRIE-Anlage Plasmaätzanlage für plasmachemisches,

reaktives Silizium-Tiefenätzen (?500µm) mittels des Bosch-Prozesses (gas chopping process)

und RIE von dünnen Dielektrika- Schichten (?2µm). - Die Anlage muss die Verarbeitung von

100mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, sowie mit und ohne Secondary-Flat erlauben. - Die

Anlage muss die Verarbeitung von 150mm Wafern mit und ohne Primary-Flat, mit und ohne

Secondary-Flat oder auch mit und ohne Notch erlauben. - Das im DRIE-Modus mögliche

Siliziumabtragsvolumen pro Zeiteinheit liegt bei bis zu ca. 2,5 mm³/s, das Wärmemanagement

ist entsprechend auszulegen. Die exakten zu erfüllenden Prozessparameter sind der

Spezifikationstabelle im Punkt "Geforderte Prozessparameter und deren Überprüfbarkeit" zu

entnehmen. - Die Anlage muss über eine separate Beschickungskammer (Vakuumschleuse,

Loadlock) verfügen, die es zulässt die spezifizierten Wafer, ohne ein Belüften der

Prozesskammer gegen Atmosphäre zu laden. - Der Probenchuck / Substratelektrode muss

über eine He-Rückseitenkühlung für die Substrate verfügen. Es muss zudem eine Vorrichtung

zur Detektion von He-Lecks in Richtung Prozesskammer beim Ätzprozess, z.B. durch

Waferbruch, vorhanden sein. - Via Mass-Flow-Controller geregelte Gaslinien für folgende

Prozessgase müssen vorhanden sein: o C₄F₈ o SF₆ o O₂ o CHF₃ o Ar o CF₄ - Um

parasitäre Abscheidung, z.B. von Fluorpolymeren, zu vermeiden muss das System über einen

aktiv geheizten Prozesskammer-Liner (?120 °C) verfügen. - Alle zum RIE- und DRIE-Betrieb

nötigen Anlagenbestandteile müssen Lieferbestandteil der Anlage sein, hierzu zählen

beispielsweise, aber nicht abschließend: o Prozesskammer o Gestell / Korpus inkl. nötige

Racks und Steuerschränke o Anlagen-Steuerung inkl. Eingabegeräte und Monitore o

Plasmaanregung / ICP Quelle mit automatisierter Matching-Unit oder Generatoren mit integrierter HF-Abstimmung o Druckmessung o Pumpsystem - Die Anlage muss für den Einbau in einem ISO 14644-1, Klasse ISO 5 Reinraum geeignet sein, Pumpsysteme können in einem Servicebereich untergebracht werden. - Die maximalen Abmessungen der Anlage dürfen inkl. notwendiger Serviceflächen maximal Höhe x Breite x Länge, 2,6m x 0,9m x 2,4m betragen. - Die zu liefernde Anlage muss über eine CE-Kennzeichnung des Gesamtsystems verfügen. Dies inkludiert die Einhaltung aller für das Anlagenkonzept einschlägigen Richtlinien, mindestens jedoch: - Richtlinie 2006/42/EG bzw. bei Lieferung ab dem 20.01.2027 Verordnung (EU) 2023/1230 - Low Voltage Directive - 2006/95/EC - EMC Directive - 2004/108/EC - Das System muss ausschließlich mit den genannten Prozessgasen, gasförmigem Helium, gasförmigem Stickstoff, Druckluft, Abluft, Kühlwasser und Elektroenergie betrieben werden. Zusätzliche Medien, wie z.B. Flüssighelium, Flüssigstickstoff oder Trockeneis dürfen nicht zum Betrieb nötig sein. - Die ICP-Quelle muss in einem Bereich von 120W bis 5000W oder weiter betreibbar sein, wobei bei einem weiteren Bereich der genannte Bereich inkludiert sein muss. 02 1 Substratelektrode Zur Probenhalterung wird aus Gründen der Homogenität und mechanischen Belastung der Wafer eine elektrostatische Klemmung gefordert. e-Chuck: - Die Substratelektrode muss für die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder die entsprechende Anzahl an Substratelektroden für die Bearbeitung der genannten Wafergrößen müssen Lieferbestandteil sein. o Im Falle der Notwendigkeit des Tausches von Teilen zur Umrüstung zwischen den Wafergrößen sind, insofern nötig oder vorgeschrieben, alle etwaigen Verschleißteile (Dichtstoffe...) für eine 50-fache Umrüstung im Lieferumfang zu integrieren. - Falls für das Erreichen der geforderten Parameter ein Heater / Chiller nötig ist, muss dieser inkl. der eventuell nötigen Integration und Steuerung Lieferbestandteil sein. 03 1 Kantenschutz der Wafer während der Ätzung Es ist für den Schutz der Waferränder (z.B. bei der Verwendung Photoresistmasken) eine Kantenabdeckung (edge protection) vorzusehen. - Der Kantenschutz muss für die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien (100 und 150mm) geeignet sein oder über die Verwendung von Carriern / Adaptern oder Bauteiltausch die Verarbeitung zulassen. - Sind Zusatzteile für die Verarbeitung aller genannten Wafergeometrien nötig, müssen alle zur Umrüstung nötigen Teile Lieferbestandteil der Anlage sein. - Sind zur Umrüstung zwischen den Wafergeometrien Verschleißteile nötig oder vorgeschrieben sind diese für eine 50-fache Umrüstung im Lieferumfang zu integrieren. - Der Kantenschutz muss nach seiner Installation im Ätzbetrieb ohne Öffnen der Prozesskammer wirksam werden. - Ist der Kantenschutz ein Verschleißteil, z.B. ein Quarzglas-Ring, sind 2 Stück je benötigter Ausführung als Lieferbestandteil zu integrieren. 04 1 Notching-Kontrolle / Reduktion der Strukturabweichung beim Ätzstopp auf Dielektrika Um das sog. Notching bei der Ätzung von silicon on insulator (SOI) Strukturen und dem Stopp auf Dielektrikamembranen zu minimieren, ist die Substratelektrode mit einem gepulsten kHz Generator zu betreiben oder ein gleichwertiges Verfahren zur Vermeidung des so genannten Notchings einzusetzen.

Menetluse tunnus: b0cb9d46-0047-4223-b712-26d0ff3227ca

Sisemine tunnus: OV 09-26

Menetluse liik: Avatud

Kiirendatud menetlus: ei

2.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

Täiendav liigitus (cpv): 42990000 Mitmesugused eriotstarbelised masinad, 31712330

Pooljuhtseadised

2.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Kornmarkt 1

Linn: Zwickau

Sihtnumber: 08056

Riik – jaotus (NUTS): Zwickau (DED45)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Westsächsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

2.1.4. Üldine teave

Lisateave: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMZEU#

Õiguslik alus:

Direktiiv 2014/24/EL

vgv -

2.1.6. Kõrvaldamise alused

Väljajätmise aluste allikad: Hankedokument

5. Osa

5.1. Osa: LOT-0001

Pealkiri: Kauf einer DRIE/ RIE-Anlage (Plasmaätzenanlage)

Kirjeldus: - Die Funktion ist innerhalb der Inbetriebnahme an Silizium-Wafern mit einer Dicke von mindestens 380µm mit einem Ätzstopp auf 1500-2500nm thermischem Siliziumdioxid nachzuweisen. Der Nachweis erfolgt durch eine Überätzung von rechnerisch >10µm nach Erreichen des Endpunktes. - Als Ätzmaske bei diesem Abnahmetest dient ebenfalls 1500-2500nm thermisches Siliziumdioxid mit geöffneten Strukturen von 250x250µm (+/-10µm) in einem x / y-Pitch von 3000µm, gleichverteilt über den Wafer. - Die Wafer werden durch den Auftraggeber im Rahmen des SAT (Anlagenabnahme am Bestimmungsort) zur Verfügung gestellt. - Die Parameter sind bei einem 100mm Wafer, innerhalb des 90mm durchmessenden Kernbereichs und bei einem 150mm Wafer innerhalb des 140mm Kernbereichs nachzuweisen (je 5mm Randausschluss). - Die durchschnittliche Ätzrate, ab dem Start der Ätzung, muss bei dem Test min. 10µm/min betragen. - Die einseitige Abweichung von der Tangente der Ätzflanke darf bei keiner Struktur mehr als 10µm betragen. 05 1 Endpunktdetektion Die Prozessüberwachung und die Endpunktkontrolle muss über die optische Analyse der Plasmaemission anhand der charakteristischen Emissionslinien erfolgen. Es muss mindestens der Bereich von 250 - 850nm zur Auswertung zugänglich sein. - Die Endpunktdetektion ist in Auflösung und Empfindlichkeit so zu realisieren, dass der Endpunkt auch bei geringen offenen Flächen <5% sicher detektiert wird. - Es sollen mindestens folgende Endpunktdetektionen bei max. 5% offener Fläche möglich sein: o Silizium-Ätzung mit Endpunkt auf SiO₂ o Silizium-Ätzung mit Endpunkt auf Al o Silizium-Ätzung mit Endpunkt auf Photoresist o SixNy-Ätzung mit Endpunkt auf SiO₂ o SixNy-Ätzung mit Endpunkt auf Si o SiO₂-Ätzung mit Endpunkt auf Si 06 1 Software und Anlagensteuerung - Die Bediensoftware muss mindestens die folgenden Nutzerniveaus enthalten: o Bediener dem nur der Start bereits vorhandener Rezepte gestattet ist. o Ingenieur dem zusätzlich das Erstellen und Ändern von Rezepten gestattet ist (wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). o Service den zusätzlich die manuelle Steuerung der Anlage und die Umgehung von Interlocks gestattet ist (wahlweise mit Passwortschutz durch den Kunden). - Wird als Betriebssystem Microsoft Windows eingesetzt, muss dieses auf Version 11 oder 10 LTSC basieren. - Die Bediensoftware muss einen automatisierten Leckagetest und MFC-Funktionstest enthalten. - Das Steuerungskonzept

muss auf einer Direct One-to-one Verbindung zu den Sensoren und Aktoren basieren (Ein Steuerungskanal zu einem Sensor oder Aktor) - Es muss eine kanalweise Diagnostik für die Steuerungskanäle vorhanden (on/off) und die entsprechende Status Information (OK, Kurzschluss, Unterbrechung) - Das Datalogging muss in Intervallen ? 250 ms möglich sein. - Für die genaue Kontrolle der zeitlichen Abfolge in den Prozessen müssen Prozessschritte bis zu einer Gesamtlänge von ? 10 ms definiert werden können. - Die Anzahl der anlegbaren Prozessrezepte soll nicht anlagenseitig auf einen Wert kleiner 5000 begrenzt sein. - Die Softwarelösung muss SEMI E95 konform gestaltet sein. 07 1 Installation/Schulung - Installation der Soft- und Hardware - Grundsicherung der Anwender (Bedienung der Soft- und Hardware, Umgang mit Betriebsmitteln, In- und Außerbetriebnahme, Wartung) - Zur Anlage ist ein Bedienerhandbuch, Servicehandbuch und Stromlaufplan in deutscher oder englischer Sprache zu liefern. 08 1 Geforderte Prozessparameter und deren Überprüfbarkeit Der Anbieter muss bestätigen, dass er über ein Applikationslabor verfügt, welches mittels öffentlicher Verkehrsmittel, einem PKW oder der Kombination beider innerhalb von 12h vom Bestimmungsort aus erreichbar ist. Innerhalb dieses Applikationslabors muss mindestens eines der angebotenen Systeme (mit den nicht optionalen Grundfunktionalitäten) betrieben werden und für Anlagentests zur Verfügung stehen. Zudem behält sich der Käufer vor, die angegebenen Parameter an dieser Anlage innerhalb des Evaluationsprozesses der Angebote vor Ort bei dem Anbieter zu überprüfen. Auf Anfrage muss diese Überprüfung innerhalb einer Woche nach Ankündigung möglich sein. Geforderte Prozessparameterkombinationen lt. Leistungsbeschreibung. Die geforderten Prozesse mit den entsprechenden Parametern sind in geeigneter Form (z.B. wie die innerhalb der in dieser Ausschreibung im Leistungsverzeichnis FB 27 verwendete Tabelle) dem Angebot beizufügen. 09 1 Verpackung / Transport / Abladen / Einbringen / Leistungsort: Westsächsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter- Breuer-Straße 5-11 08056 Zwickau Lieferung nach Incoterms 2020 DAP oder DDP, Fracht bis zur ebenerdig und rollend mit erreichbaren Entladestelle an der Lieferzufahrt Dr.- Friedrichs-Ring 2C, 08056 Zwickau, Deutschland Lieferzeit: max. 50. KW nach Beauftragung Sisemine tunnus: OV 09-26

5.1.1. Eesmärk

Lepingu olemus: Asjad

Peamine liigitus (cpv): 38000000 Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid)

Täiendav liigitus (cpv): 42990000 Mitmesugused eriotstarbelised masinad, 31712330

Pooljuhtseadised

Täiendavad hankevõimalused:

Täiendavad hankevõimalused kirjeldus: 1.) Optionale Nachrüstbarkeit eines Cryoprozesses 2.)

Optionale Erweiterbarkeit zu einem Clustersystem

5.1.2. Lepingu täitmise koht

Postiaadress: Kornmarkt 1

Linn: Zwickau

Sihtnumber: 08056

Riik – jaotus (NUTS): Zwickau (DED45)

Riik: Saksamaa

Lisateave: Westsächsische Hochschule Zwickau Hochtechnologiezentrum Peter-Breuer-Str. 5-11 08056 Zwickau Deutschland

5.1.3. Eeldatav kestus

Kestus: 50 Nädalat

5.1.6. Üldine teave

Reserveeritud osalemine:

Osalemine ei ole reserveeritud.

Hankeprojekt, mida rahastatakse täielikult või osaliselt ELi vahenditest

Hanke suhtes kohaldatakse riigihankelepingut (GPA): ei

See hange sobib ka väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKE'd): ei

Lisateave: zu 1.) Es sollte möglichst die Nachrüstbarkeit einer Substratelektrode für Cryo-Prozesse gegeben sein, welche Prozessführungen bis zu einer Substrattemperatur von -150C zulässt. Diese Option darf die Nachrüstung einer mechanischen Substratklemmung und den Einsatz von Zusatzmedien (z.B. Flüssigstickstoff) nötig machen. zu 2.) Optionaler späterer Ersatz des Loadlocks (Waferschleuse) durch ein Transfersystem bei welchem eine Waferkassettenstation und min. 2 weitere Prozessmodule (z.B. PE-CVD, ALD oder RIE/ DRIE) angeschlossen werden können, um die Anlage funktionell zu erweitern.

5.1.7. Strateegilised hanked

Strateegilise hanke eesmärk: Ei kohaldata strateegilist hanget

5.1.9. Kvalifitseerimistingimused

Valikukriteeriumide allikad: Teade

Kriteerium: Tööriistad, taimed või tehnilised seadmed

Valikukriteeriumi kirjeldus: Nachweis über Vorhandensein eines Applikationslabors bei Bieter

5.1.10. Pakkumuste hindamise kriteeriumid**Kriteerium:**

Liik: Hind

Nimi: Preiskriteerium

Kirjeldus: Preiskriteerium

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 30

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Erfüllung der Leistungsparameter

Kirjeldus: Erfüllung der Leistungsparameter

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 60

Kriteerium:

Liik: Kvaliteet

Nimi: Lieferzeit

Kirjeldus: Lieferzeit

Hindamise kaalukriteeriumi kategooria: Kaal (punktid, täpne)

Hindamiskriteerium – arv: 10

5.1.11. Hankedokumendid

Keeled, milles hankedokumendid on ametlikult kättesaadavad: saksa keel

Lisateabe taotlemise tähtaeg: 03/07/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Hankedokumentide aadress: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU/documents>

Sihtotstarbeline teabevahetuskanal:

URL: <https://www.dtv.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU>

5.1.12. Hanke tingimused**Esitamise tingimused:**

Elektrooniline esitamine: Nõutav

Esitamise aadress: <https://www.dtyp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMZEU>

Keeled, milles võib pakkumusi või osalemistaotlusi esitada: saksa keel

Elektroniline kataloog: Ei ole lubatud

Variandid: Ei ole lubatud

Pakkujad võivad esitada rohkem kui ühe pakkumuse: Ei ole lubatud

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10/07/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Periood, mille jooksul pakkumus peab jääma kehtivaks: 9 Nädalat

Teave, mida saab pärast esitamise tähtaega täiendada:

Ostja äranägemisel võib kõik puuduvad pakkujaga seotud dokumendid esitada hiljem.

Lisateave: Der Auftragnehmer behält sich vor, Unterlagen zur Aufklärung nachzufordern.

Teave avaliku avamise kohta:

Avamise kuupäev: 10/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Lepingutingimused:

Lepingu täitmine peab toimuma kaitstud tööhõive programmide raames: Ei

E-arveldamine: Nõutav

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi: ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid: ei

5.1.15. Vahendid

Raamleping:

Ei kohaldata raamlepingut

Teave dunaamilise hankesüsteemi kohta:

Ei kohaldata dunaamilist hankesüsteemi

5.1.16. Lisateave, lepitus ja vaidlustus

Vaidlustusorgan: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta: Westsächsische Hochschule Zwickau

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused: Westsächsische Hochschule Zwickau

8. Organisatsioonid

8.1. ORG-0001

Ametlik nimi: Westsächsische Hochschule Zwickau

Registreerimisnumber: 14-1215011WHZ01-34

Postiaadress: Kornmarkt 1

Linn: Zwickau

Sihtnumber: 08056

Riik – jaotus (NUTS): Zwickau (DED45)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: Beschaffungswesen@whz.de

Telefon: 03755361131

Internetiaadress: <https://www.whz.de>

Hankija profiil: <https://www.whz.de>

Selle organisatsiooni rollid:

Hankija

Keskne hankija, kes sõlmib teiste hankijate jaoks ette nähtud ehitustööde, asjade või teenuste riigihankelepinguid või raamlepinguid
Organisatsioon, mis annab lisateavet hankemenetluse kohta
Organisatsioon, millele laekuvad osalemistaotlused

8.1. ORG-0002

Ametlik nimi: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Registreerimisnumber: ohne

Linn: Leipzig

Sihtnumber: 04013

Riik – jaotus (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: vergabekammer@lds.sachsen.de

Telefon: +49 03419773800

Selle organisatsiooni rollid:

Vaidlustusorgan

Organisatsioon, mis annab lisateavet vaidlustamise kohta

8.1. ORG-0003

Ametlik nimi: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI)

Registreerimisnumber: 0204:994-DOEVD-83

Linn: Bonn

Sihtnumber: 53119

Riik – jaotus (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Riik: Saksamaa

E-posti aadress: noreply.esender_hub@bescha.bund.de

Telefon: +49228996100

Selle organisatsiooni rollid:

TED eSender

Teave teate kohta

Teate tunnus/version: 2ccf26c1-6b0a-47ce-8228-ad9b97611ff8 - 01

Vormi liik: Hange

Teate liik: Hanketeade või kontsessiooniteade – üldkord

Teate alaliik: 16

Teate saatmise kuupäev: 04/06/2026 09:00:02 (UTC+02:00) Ida-Euroopa aeg, Kesk-Euroopa suveaeg

Keeled, milles käesolev teade on ametlikult kättesaadav: saksa keel

Teate avaldamise number: 388383-2026

ELT S väljaande number: 107/2026

Avaldamise kuupäev: 05/06/2026